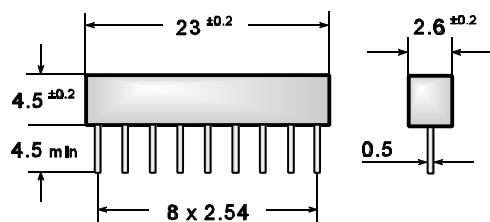


Fast Switching Rectifier Arrays

Schnelle Gleichrichter Sätze



Dimensions / Maße in mm

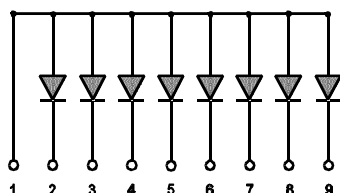
Nominal power dissipation 1.2 W
Nenn-Verlustleistung

Repetitive peak reverse voltage 100...1000 V
Periodische Spitzensperrspannung

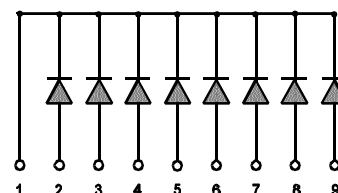
9 Pin-Plastic case 23 x 2.6 x 4.5 [mm]
9 Pin-Kunststoffgehäuse

Standard packaging: bulk
Standard Lieferform: lose im Karton

Weight approx. 0,6 g
Gewicht ca.



"DAF 811 A...8110 A": com. anodes / gem. Anode



"DAF 811 K...8110 K": com. kathodes / gem. Kathode

Maximum ratings

Grenzwerte

Type	Repetitive peak reverse voltage	Surge peak reverse voltage
Typ	Periodische Spitzensperrspannung	Stoßspitzensperrspannung
	V_{RRM} [V]	V_{RSM} [V]
DAF 811 A/K	100	120
DAF 814 A/K	400	480

Max. average forward rectified current, R-load, $T_A = 25^\circ\text{C}$
For one diode operation only $I_{FAV} = 600 \text{ mA}^{1)}$
For all diodes together $I_{FAV} = 150 \text{ mA}^{1)}$

Dauergrenzstrom in Einwegschtung mit R-Last, $T_U = 25^\circ\text{C}$
Nur eine Diode im Einsatz $I_{FAV} = 600 \text{ mA}^{1)}$
Für alle Dioden zusammen $I_{FAV} = 150 \text{ mA}^{1)}$

Peak fwd. surge current, 50 Hz half sine-wave, $T_A = 25^\circ\text{C}$ $I_{FSM} = 30 \text{ A}$
superimposed on rated load, one diode only
Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellen,
überlagert bei Nennlast, für eine Diode

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Max. power dissipation – Verlustleistung	$T_A = 25^\circ\text{C}$	P_{tot}	$1.2 \text{ W}^1)$
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	$-50\dots+150^\circ\text{C}$
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_s	$-50\dots+150^\circ\text{C}$

Characteristics**Kennwerte**

Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 1 \text{ A}$	V_F	$< 1.1 \text{ V}$
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 100^\circ\text{C}$	$V_R = V_{\text{RRM}}$ $V_R = V_{\text{RRM}}$	I_R I_R	$< 10 \mu\text{A}$ $< 90 \mu\text{A}$
Reverse recovery time Sperrverzögerung	$I_F = 10 \text{ mA}$ through/über $I_R = 10 \text{ mA}$ to/auf $I_R = 1 \text{ mA}$		t_{rr}	$< 350 \text{ ns}$
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			R_{thA}	$< 85 \text{ K/W}^1)$

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case

Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden